



2SA1577W (3CG1577W)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于中功率放大。

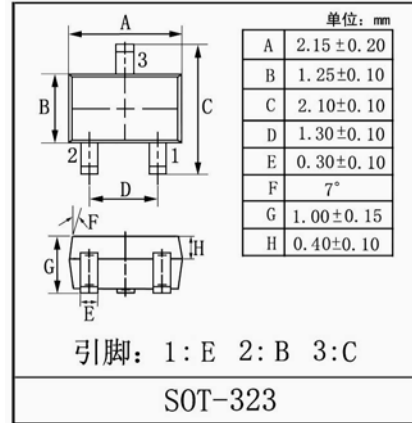
Purpose: Medium power amplifier applications.

特点:集电极直流电流大, 饱和压降低, 与 2SC1741S (3DG1741S) 互补。

Features: .Large I_c low $V_{ce(sat)}$, complementary pair with the 2SC1741S(3DG1741S).

极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-40	V
V_{CEO}	-32	V
V_{EBO}	-5.0	V
I_C	-500	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CBO}	$I_C = -100 \mu\text{A}$	-40			V
V_{CEO}	$I_C = -1.0\text{mA}$	-32			V
V_{EBO}	$I_E = -100 \mu\text{A}$	-5.0			V
I_{CBO}	$V_{CB} = -20\text{V}$			-1.0	μA
I_{EBO}	$V_{EB} = -4.0\text{V}$			-1.0	μA
h_{FE}	$V_{CE} = -3.0\text{V}$ $I_C = -10\text{mA}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}$ $I_B = -10\text{mA}$			-0.4	V
f_T	$V_{CE} = -5.0\text{V}$ $I_E = 20\text{mA}$ $f = 100\text{MHz}$		200		MHz
C_{ob}	$V_{CB} = -10\text{V}$ $I_E = 0$ $f = 1.0\text{MHz}$		7.0		pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	P	Q	R
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	82~180	120~270	180~390
印章 Marking	HHP	HHQ	HHR



2SA1577W (3CG1577W)

